**半导体激光治疗仪参数要求**

1、激光媒介：GaAlAs - 半导体

2、输出波长：主波长800nm±10nm 辅助波长650nm±10nm

3、输出模式：连续 或 间歇

4、工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射

5、最大功率： 单个面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80

单个激光器最大输出功率500mw，调节范围20-500mw，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%。

6、照射面积： 单个面照治疗头24cm±0.2cm×14cm±0.2cm单个面照射面积：≥33000mm²

7、激光器数量：单个面照治疗头激光管不少于80个，整机激光器总数量≥160个

8、输出激光功率不稳定度st：优于±10%

9、输出激光功率复现性Rp：优于±10%